

## 注意事項

1. 使用限制: 本機台為 6、4 吋設備，僅限定使用中心內部晶圓片進行磊晶製程。
2. 僅限全片磊晶，無破片製程。
3. 高溫磊晶條件最高至 1100°C。
4. 為避免 particle 汙染以及真空度影響，不開放 re-growth 磊晶技術，建議與負責人討論。
5. 此設備以 HEMT 磊晶結構為主，結果可能需另送 AFM、XRD、TEM 觀測，才能再行調整。材料分析觀測需自行委託材料分析組進行觀測。
6. 非標準製程務必和機台負責工程師連絡討論可行性，欲送件前如有任何問題請與機台負責工程師連絡。